

索引(汉英对照)

二 画

二极管(Diode) 68

点接触型(point contact type) ~ 69

面结型(junction type) ~ 69

~ $V-I$ 特性($V-I$ characteristic) 69

~ 参数(parameters) 71

~ 直流电阻(direct current resistance) 75

~ 微变电阻(increment resistance) 76

~ 反向峰值电压(reverse peak voltage) 71

~ 势垒电容(barrier capacitance) 67

~ 扩散电容(diffusion capacitance) 67

齐纳(Zener) ~ 85

变容(varactor) ~ 88

发光(light-emitting) ~ 91

光电(photo) ~ 90

激光(laser) ~ 92

~ 理想模型(ideal model) 74

~ 恒压降模型(constant voltage drop model) 74

~ 折线模型(piecewise model) 74

~ 小信号模型(small signal model) 76

三 画

三极管(Bipolar Junction Transistor, BJT) 101

~ 结构(construction) 102

~ 特性曲线(characteristics) 107

~ 参数(parameters) 111

~ 放大区(active region) 109

~ 基极体电阻($r_{bb'}$) (base-spreading resistance) 129

~ 偏置电路(biasing circuits) 116

~ 击穿电压(breakdown voltage) 113

~ 截止区(cutoff region) 109

~ 饱和区(saturation region) 109

~ 共基组态(common-base configuration) 105

~ 共射组态(common-emitter configuration) 105

~ 互补对称(complementary symmetry) 386

~ 电流增益(current gain) 106

~ 图解分析(graphical analysis) 119

~ 混合 Π 形模型(hybrid Π model) 160

~ 结电压值(junction voltage values)

横向 PNP(lateral PNP) ~ 403, 282

~ 极限参数(定额)(ratings) 112

多集电极(Multiple collector) ~ 282

三角波发生器(Triangle-wave generator) 466

小信号模型(Small signal model) 76